



一种提高窄禁带半导体光阳极光电催化放氧反应稳定性的方法

文献类型: 专利

...

作者 李灿; 刘桂继; 施晶莹; 章福祥; 丁春梅; 陈政

发表日期 2015-11-01

专利国别 CN

专利号 CN201310693176.5

专利类型 发明

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 否

中文摘要 本发明提供了一种提高窄禁带半导体光阳极光电催化放氧反应稳定性的方法。通过在窄禁带半导体光阳极表面修饰空穴储存层的方法,抑制在半导体光阳极表面发生的光致自氧化腐蚀反应引起的性能衰减,促使光阳极光电催化放氧反应的稳定进行。利用本发明提供的方法,能够使窄禁带半导体光阳极的活性工作寿命由数分钟提升至数小时以上,这为实现太阳能分解水制氢技术的工业应用提供了一条崭新的途径。

学科主题 物理化学

公开日期 2015-06-17

授权日期 2015-11-01

申请日期 2013-12-13

语种 中文

专利申请号 CN201310693176.5

源URL [<http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/144778>]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

作者单位 中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 李灿,刘桂继,施晶莹,等. 一种提高窄禁带半导体光阳极光电催化放氧反应稳定性的方法,一种提高窄禁带半导体光阳极光电催化放氧反应稳定性的方法,一种提高窄禁带半导体光阳极光电催化放氧反应稳定性的方法,一种提高窄禁带半导体光阳极光电催化放氧反应稳定性的方法. CN201310693176.5. 2015-11-01.

入库方式: OAI收割

来源: 大连化学物理研究所

浏览	下载	收藏
108	0	0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

